

Название:	Создание производства кристаллов и пластин из арсенида галлия
Участники проекта:	НИИ ПП, ТГУ, ООО «Наноспектр», ОАО «Манотомь»
Описание проекта:	<p>Целью реализации проекта является формирование инфраструктуры производства полупроводниковых материалов, в частности, GaAs диаметром 100-150 мм и широкого спектра ЭКБ функциональной электроники и квантовочувствительной сенсорики для технологий и систем двойного назначения. Общая стоимость проекта по экспертной оценке - более 2 млрд. руб.</p>
Готовность вывода на рынок:	Технологии выращивания кристаллов и получение пластин модифицированных хромом отработаны.
Экспонат фото:	Номенклатура и объем выпускаемой продукции
<p style="text-align: center;">Образцы продукции</p>  <p>Пример устройства, в котором будут использоваться медицинские детекторы нового поколения</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слитки (монокристаллы) GaAs диаметром 3, 4 и 6 дюймов, ожидаемый объем выпуска – 6 млн\$/год. 2. Пластины полированные GaAs диаметром 3, 4 и 6 дюймов, ожидаемый объем выпуска – 12 млн\$/год. 3. Пластины HR-GaAs:Cr и HR-GaAs:Cr,Fe диаметром 3, 4 и 6 дюймов, ожидаемый объем выпуска – 12 млн\$/год. 4. Микрополосковые детекторы для малодозовых сканирующих рентгеновских систем, ожидаемый объем выпуска – 8 млн\$/год. 5. Матричные детекторы для широкого спектра цифровых цветowych рентгеновских систем медицинского, промышленного и научного назначения, ожидаемый объем – 18 млн\$/год. 6. Радиационностойкие микрополосковые и матричные детекторы для обеспечения исследований и исследовательской инфраструктуры синхротронных источников 4-го поколения, ожидаемый объем выпуска – 14 млн\$/год.